気になる論文コーナー

脳皮質電気刺激の生体内イメージング:高速内因性光信号対電位感受性色素

Imaging Cortical Electrical Stimulation *In Vivo*: Fast Intrinsic Optical Signal Versus Voltage-Sensitive Dyes [V. Tsytsarev, K. Premachandra, D. Takeshita and S. Bahar: Opt. Lett., **33**, No. 9 (2008) 1032–1034]

電位感受性色素 (voltage-sensitive dye; VSD) は電位変化を蛍光強 度変化に変換する一種のケミカルプローブであり,マイクロ秒以下の 高速な応答が得られることから,近年,脳神経細胞興奮時の膜電位の 脱分極変化を直接イメージングする外因性光信号計測手法のひとつと して注目されている.一方で,神経活動変化時の組織代謝変化(血流 量変化,ヘモグロビンの酸化-還元変化)に起因する反射光強度変化を とらえる内因性光信号イメージング法も広く研究されている.従来か らの内因性光信号を用いた皮質表面のイメージングでは,神経刺激に 対して比較的遅く緩やかな時間応答成分が解析の対象とされる場合が 多い.著者らは,内因性光信号の早い時間応答成分である fIOS (fast intrinsic optical signal) に着目し, fIOS と VSD 蛍光の双方による高時 間分解イメージングを,電気刺激時に対するラット大脳皮質体性感覚 野の時・空間特性の観察に応用している.

VSD による蛍光イメージングでは、電位感受性色素(RH-795 または RH-1691)により染色したラット露出脳にタングステンフィラメント ランプからの光をヒートミラーと干渉フィルター(546±30 nm または 630±20 nm)を介して照射することで励起される蛍光強度変化を、ま た、fIOS イメージングでは、波長 694 nm の光を照明した際の反射光 強度変化を計測している.電気刺激強度は 100 μ A であり、双極電極に よりパルス幅 0.2 ms のトレイン刺激を 300 Hz で計 10 ms 与えてい る. 蛍光強度変化および反射光強度変化の画像はいずれもフレーム レート 100 Hz で取得され、ノイズの影響を軽減するために 30 回の加 算平均処理がなされている.

皮質表層の fIOS は VSD 信号と同様に電気刺激後 30 ms 以内で観測 され, 従来からよく知られている内因性光信号の遅い応答に先だって 現れることを確認している. さらに, fIOS が刺激電極近傍のみで観測 されるのに対して, VSD 信号は fIOS よりも広範囲に広がる結果が得 られている. 観測された fIOS の起源として, 膜電位の脱分極に伴う膜 透過性イオンの移動により生じる神経細胞組織の体積変化と光散乱特 性変化が議論されている. (図 2, 文献 11)

本論文では、内因性光信号においても VSD 蛍光と同程度の早い時間 応答が得られている点や、fIOS と VSD 蛍光の空間的応答特性が異な る点が興味深い. 今後は、照明光の波長と fIOS の時・空間応答特性と の関係に関する検討が行われることを期待したい. (西舘 泉)

可視光領域におけるロールアップメタマテリアル

Rolled-Up Three-Dimensional Metamaterials with a Tunable Plasma Frequency in the Visible Regime [S. Schwaiger, M. Bröll, A. Krohn, A. Stemmann, C. Heyn, Y. Stark, D. Stickler, D. Heitmann and S. Mendach: Phys. Rev. Lett., **102**, No. 16 (2009) 163903]

メタマテリアルは、透明マントなどのさまざまな応用が可能なた め、活発に研究されているが、波長以下の構造を作製する必要がある ため、実現が難しい.著者らは、自己組織化の手法を用いたメタマテ リアルの新規作製方法を開発した.その作製方法は、通常のプレー ナーな作製プロセスで、まず GaAs 基板に AlAs 犠牲層を成膜し、その 上に InGaAs/GaAs/Ag 層を積層する.その後、犠牲層の端部を選択 エッチングすることで、InGaAs 層が基板からリリースされ、InGaAs 層の歪み緩和により、図のように複数回巻きの外側半径が数 μ m 程度 のマイクロチューブができあがる.この構造は、半径方向と周方向に 対する異方性媒質となり、回折限界を超えたレンズ、いわゆるハイ パーレンズ (HL)として機能する.さらに著者らは、InGaAs/GaAs 層 厚を 34 nm で固定し、Ag 層厚を 17, 19, 22 nm と変えることで、4 回 から6回巻きになることを、透過率測定により確かめた、透過率測定 は、マイクロチューブ内に、先端に微小孔を開けたファイバーを挿入 し、その微小孔からチューブ外に放射される透過光強度を測定するこ とで行い、その結果は計算値ともよい一致を示した. さらに、このマ イクロチューブでの HL の数値計算を行い、250 nm 間隔の波長 685 nm の点光源からの光が 305 nm 間隔へと、約 1.2 倍拡大できることを計算 で確かめた.(図 5, 文献 26)

今後は、ハイパーレンズの実証実験、および半導体材料を活用した アクティブな素子への展開も期待される. (水谷 彰夫)



作製したロールアップ メタマテリアルの模式図

InGaN p-i-n ホモ接合太陽電池の作製とその特性

Fabrication and Characterization of InGaN p-i-n Homojunction Solar Cell [X. Cai, S. Zeng and B. Zhang: Appl. Phys. Lett., **95**, No.17 (2009) 173504]

近年,世界的に高効率な太陽電池の開発が盛んに進められており, 高効率化の方法のひとつとして,可視光全域で吸収波長を制御可能な 窒化物半導体である InGaN が太陽電池材料として期待されている. 著者らは,GaN/InGaN ヘテロ接合に対して格子不整合の影響低減が 期待される In_xGa_{1x}N ホモ接合による太陽電池の試作と,その特性を報 告している.本論文での試作デバイスは In 組成比 x が 0.02, 0.12, 0.15 の 3 種類であり,それぞれの In 組成比に対応した吸収端での良好な波 長対応と高い変換効率(40%,33%,30%)を示していることを報告 している.しかしながら,In 組成比を大きくしていくことにより試作 デバイスの開放電圧が低下する結果も示しており,過去の報告データ とあわせて InGaN 太陽電池における大きな課題のひとつであるとし ている.低下の理由として,In 組成比の増大に伴う InGaN の結晶品質 の低下(欠陥の増大)により,太陽電池内での電子・正孔の寿命が短

くなることであると結論づけている.(図5,表1,文献17) InGaNホモ接合太陽電池による幅広い波長に対応する高効率化の可 能性は示されているものの,結晶品質の低下が大きな課題である.実 際に InGaN ホモ接合の特徴を生かすためには,より高い In 組成比の InGaN による対応波長領域の拡大が必須になる. In 組成比によらず



光科学及び光技術調査委員会

ヒト皮膚の線走査型反射光共焦点顕微鏡法について:照明 / 検出光路非分離構成と分離構成との比較

Line-Scanning Reflectance Confocal Microscopy of Human Skin: Comparison of Full-Pupil and Divided-Pupil Configurations [D. S. Gareau, S. Abeytunge and M. Rajadhyaksha: Opt. Lett., **34**, No. 20 (2009) 3235–3237]

共焦点顕微鏡はヒト皮膚の細胞や細胞核のイメージングによく使われており、1 点からの反射光を検出する点走査方式が主流となっている. 著者らは、今後は小型・低コストが期待できる線走査方式が主流になると考え、開発を行ってきた.本論文では、以前に開発した照明と検出の光路を分離する瞳を使った共焦点顕微鏡法(以下、分離型)と、今回開発した分離なしの単純な構成の瞳を使った顕微鏡法(以下,非分離型)との比較を行った.強散乱のヒト皮膚での光学切片厚さの FWHM を比較すると、分離型では $9.2\pm1.7 \mu$ m、非分離型では $2.8\pm0.8 \mu$ m であった.また、ヒト皮膚の *in vivo* 画像を比較したところ、非分離型が分離型に比べて低コントラストでノイズが多くみられた.これは、分離型では照明の光路と検出の光路とが角度的に分離されているため、バックグラウンド光がよりよく除去できたからである.以上より、分離型と非分離型の選択は、表に示すようにトレードオフであることがわかった.(図3、表1、文献8)

X-Y 方向の移動が必要な点走査ではなく、1 方向のみの移動で短時

間に画像が取得できる線走査の共焦点顕微鏡の開発によって、被験者 の負担を減らし、無意識の呼吸やぶれなどの短時間の径時変化を除去 した、より精度の高い *in vivo* 画像の取得に貢献できると期待される. (佐野恵美子)



高輝度狭ビーム 850 nm 帯 GaAs/AlGaAs フォトニックバンド結晶レーザーと単ーモードアレイ

High-Brightness and Ultranarrow-Beam 850-nm GaAs/AlGaAs Photonic Band Crystal Lasers and Single-Mode Arrays [T. Kettler, K. Posilovic, L. Y. Karachinsky, P. Ressel, A. Ginolas, J. Fricke, U. W. Phol, V. A. Shchukin, N. N. Ledentsov, D. Bimberg, J. Jönsson, M. Weyers, G. Erbert and G. Tränkle: IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., **15**, No. 3 (2009) 901–908]

近赤外高出力半導体レーザーは固体レーザーのポンプ光源などに利用されているが、特に材料加工への応用のために、高出力なうえ高輝度なレーザーの実現が求められている。そのためにはレーザー出射光の垂直方向発散角を低減させる必要があるが、薄いコア層や導波モード拡大層を用いる方法では、レーザー動作の安定性に問題があった。本論文では、活性層下部に垂直方向一次元フォトニック結晶を導入することで基本導波モードを垂直方向に拡大し、垂直方向ビーム発散角を大幅に低減した 850 nm 帯高輝度レーザーの実現に成功した。チャネル幅 50 μ m のブロードエリアレーザーをパルス駆動し、最大出力20 W、外部微分量子効率71%、ビーム発散角9.5°(||)×11.3°(⊥)、輝度3×10⁸ W・cm⁻²・sr⁻¹の高輝度出力が得られた。さらにチャネル幅2 μ m、中心間隔25 μ m で 64、128、256 チャネルのレーザーアレイを作製し、すべてのレーザーが閾値電流70 mA で一様に安定パルス動作することを確認した。(図 10、文献 22)

本論文では活性層下部に垂直方向一次元フォトニック結晶を導入す ることにより,850 nm 帯高出力高輝度半導体レーザーの実現に成功した. 今後,材料加工などへ応用分野の拡大が期待できる.

(上向井正裕)



フォトニックバンド結晶レーザー出射光の強度分布

二次元モノジェニックウェーブレット変換を用いたロバストなステレオマッチング

Robust Stereo Image Matching Using a Two-Dimensional Monogenic Wavelet Transform [J. Li, H. Zhao and C. Shi: Opt. Lett., **34**, No. 22 (2009) 3514–3516]

おもにマシンビジョン等の分野において,ステレオ視の精度は重要 な課題である.しかし,従来手法では画像の一部分同士の一致度を比 較しているため,画像間のシフト・倍率・方向の違いや雑音の影響を 受けやすかった.ウェーブレット変換を使うことで影響を軽減できる が,特に倍率や回転について完璧なものはなかった.著者らは,モノ ジェニックウェーブレット変換(MWT: monogenic wavelet transform)を用いることで,この問題を解決している.この MWTを使う と,画像を振幅・位相・方向の3つの成分に分割できる.MWT自体 は位相シフトに対して共変だが,振幅は位相シフトに対して不変とい う特徴をもつため,画像間のずれ量を位相・方向それぞれ独立に比較 することができる.そのため,最適な MWT ウェーブレットを求める ための最適化処理を行った.その結果,2枚のステレオ画像から測距 をしたところ,5秒という短時間で従来手法より精度よく測ることが できた.(図3,表1,文献12)

本手法はステレオ視だけでなく、高速かつ高精度であることから画

像のつなぎ合わせ等の応用も考えられる.今後の動向に注目したい. (山下 敏行)

